

Спинволновая спектроскопия

Анализ главных факторов, влияющих на дисперсионную кривую спиновой волны - проводимость гранулированной структуры, неоднородность магнитных параметров по толщине, наличие проводящего слоя вблизи гранулированной структуры, наличие слоя вблизи гранулированной пленки, магнитные характеристики которого отличны от ее характеристик, показал, что они по-разному изменяют форму дисперсионных кривых, что дает возможность определения магнитных и электрических характеристик магнитныхnanoструктур (Рис. 1 и 2).

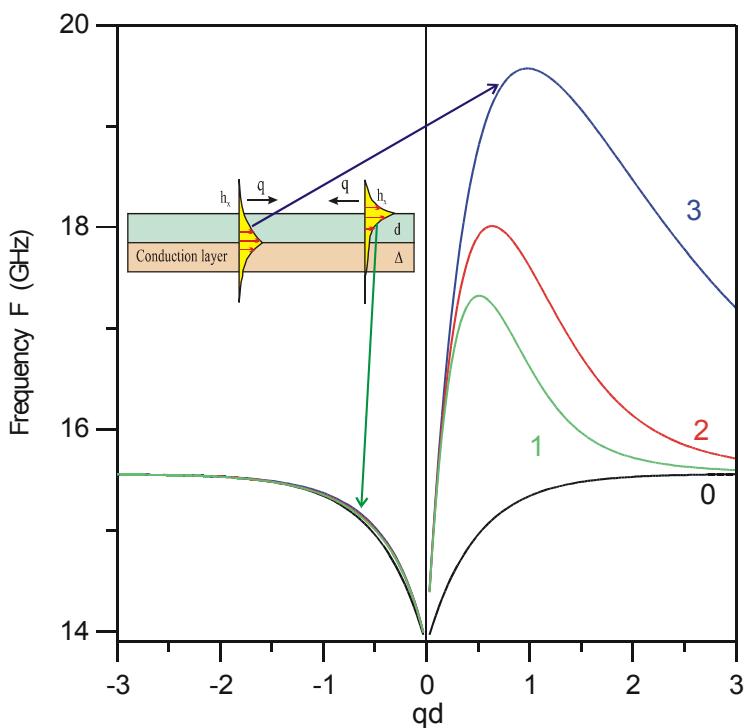


Рис. 1. Влияние проводимости σ слоя толщиной 10 $\mu\text{м}$ на дисперсионные кривые поверхностных спиновых волн (DE-моды), распространяющихся в магнитной пленке вдоль разных поверхностей. Намагниченность пленки $4\pi M = 5$ кОе, толщина $d = 400$ нм. Магнитное поле H равно 3 кОе. Проводимость слоя σ . (0) - 0, (1) - 10^4 , (2) - $2 \cdot 10^4$, (3) - $1 \cdot 10^5$ ($\Omega \cdot \text{см}$) $^{-1}$. Волновой вектор q нормирован на толщину пленки d .

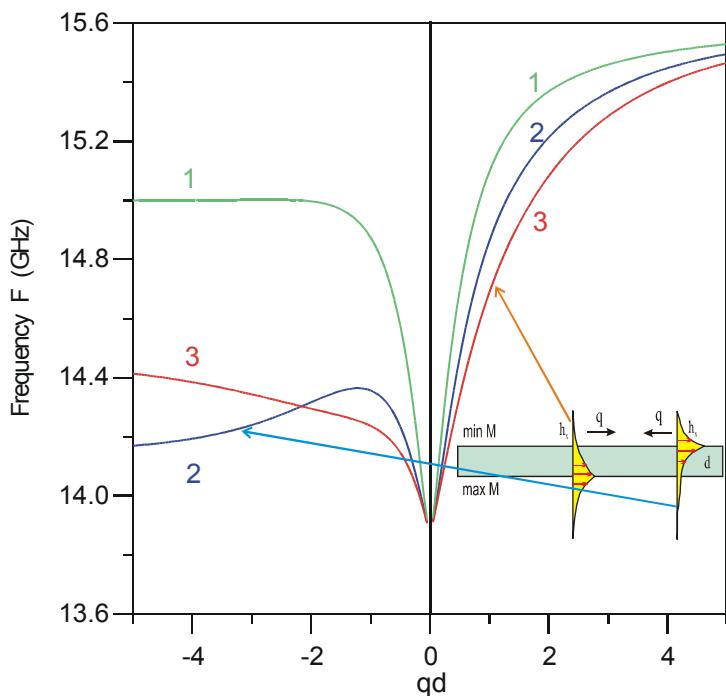
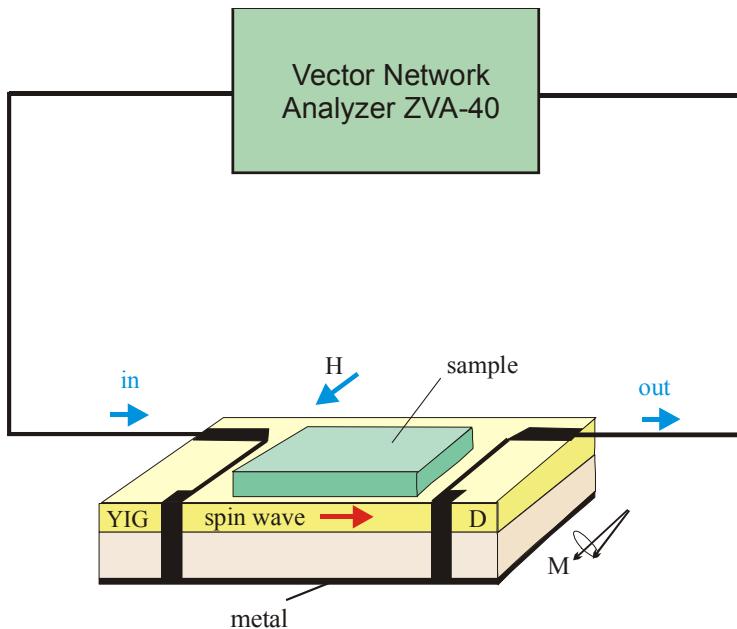


Рис. 2. Влияние градиента намагниченности ζ пленки с профилем намагниченности $4\pi M(z) = 5$ кОе - ζz на дисперсионные кривые поверхностных спиновых волн (DE-моды), распространяющихся вдоль разных поверхностей. Толщина пленки $d = 400$ нм. Магнитное поле H равно 3 кОе. Градиент намагниченности ζ : 1 - 1, 2 - 2.5, 3 - 5 кОе/ $\mu\text{м}$. Волновой вектор q нормирован на толщину пленки d .

Решение задачи определения этих характеристик из дисперсионных зависимостей спиновых волн позволило разработать метод спинволновой спектроскопии [5]. Схема измерений показана на рис. 3. В методе спинволновой спектроскопии образец гранулированной структуры помещался на пленку $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG), имеющей микрополосковые антенны для возбуждения и приема спиновых волн. Переменное магнитное поле h поверхности спиновой волны, распространявшейся в пленке YIG, взаимодействовало с образцом, что приводило к изменениям дисперсионной зависимости, групповой скорости и затухания спиновой волны. Для определения дисперсионных зависимостей и групповых скоростей спиновых волн использовались амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики (S -параметры), которые снимались с помощью векторного анализатора Rohde-Schwarz ZVA-40. Относительное изменение групповой скорости, которое измерялось по фазовому сдвигу наведенного тока на приемной антенне, определялось соотношением $w = v_g^{(s)}/v_g^{(0)}$, где $v_g^{(s)}$ и $v_g^{(0)}$ – групповые скорости, соответственно, с образцом и без образца.

(a)



(b)

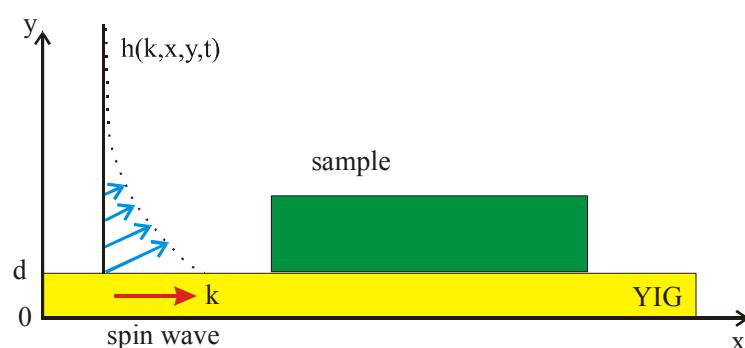


Рис. 3. (a) Блок-схема установки и спинволновой ячейки.

(b) Распределение переменного магнитного поля $h(k,x,y,t)$ поверхности спиновой волны по оси Oy при данном волновом векторе k .

Метод спинволновой спектроскопии применен к структурам а-C:H с наночастицами Cu, SiO₂ с наночастицами Co, ZnO(Co), BaTiO₃ с наночастицами Ni, а-C:H с наночастицами Co и к структурам аморфного SiO₂ с гранулами сплава Co₈₆Nb₁₂Ta₂ [6, 7]. Генерация вихревых токов в проводящих гранулированных структурах, расположенных в области распространения спиновой волны, приводит к увеличению ее групповой скорости (Рис. 4). Если гранулированная структура содержит магнитные наночастицы, то при их малой концентрации вследствие спин-поляризационной релаксации спиновых возбуждений, наблюдается рост затухания спиновой волны в пленке YIG и падение ее групповой скорости (Рис. 5). При более высоких концентрациях металлических наночастиц наступает область переколяционного порога, что приводит к росту проводимости образцов и к росту групповой скорости спиновой волны.

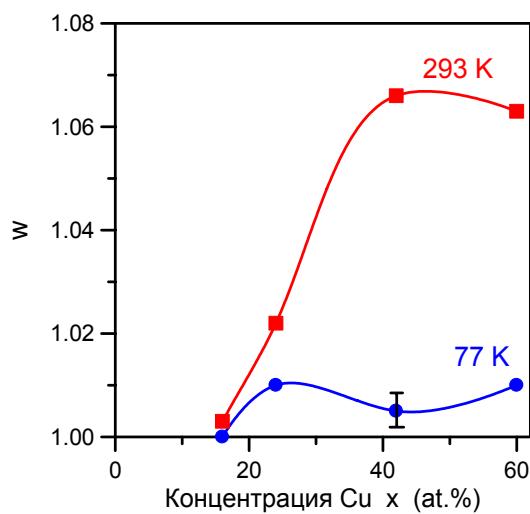


Рис. 4. Изменение w групповой скорости спиновой волны в YIG пленке (14 μm) со слоем (а-C:H)_{100-x}Cu_x толщиной 50 nm к групповой скорости ненагруженной пленки YIG в зависимости от степени вхождения наночастиц Cu (2 – 3 nm) x при 77 K и при 293 K.

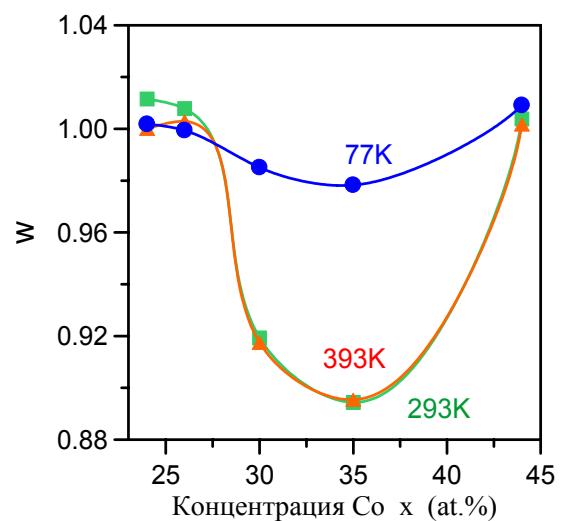


Рис. 5. Изменение w групповой скорости спиновой волны в YIG пленке, взаимодействующей с образцами (а-C:H)_{100-x}Co_x, в зависимости от концентрации Со x при температурах 77, 293 и 393 K.